








	<h2>R6008FNJTL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R6008FNJTL</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 8A LPTS</p> <p>Datenblätter:  R6008FNJTL.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 55000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6008FNJTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 8A LPTS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	55000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-83
Supplier Device-Gehäuse	LPTS
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	580pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































R6008FNJTL ist neu im Original, Suche R6008FNJTL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie R6008FNJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage R6008FNJTL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>R6009ENJTL LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A LPT</p>	 <p>R6007KNX LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A TO220-3</p>	 <p>R6008FNX LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 8A TO-220FM</p>	 <p>R6008FNJ ROHM R6008FNJ ROHM</p>
 <p>R6009ENX LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p>	 <p>R6009-00 Harwin BRD SPT SNAP FIT/LOCK NYLN 9.5MM</p>	 <p>R6008ANX LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 600V 8A TO-220FM</p>	 <p>R6008ANJ ROHM R6008ANJ ROHM</p>

heiße Teile

Mehr

 R6000B-O-I200	 R6001030XXYA	 R6001030XXYA	 R6001225XXYA	 R6001230XXYA
 R6001420XXYA	 R6001425XXYA	 R6001430XXYA	 R6001620XXYA	 R6001625XXYA
 R6001630XXYA	 R6001820XXYA	 R6001825XXYA	 R6004CND	 R6004CNDTL
 R6004END	 R6004ENJ	 R6004ENX	 R6006ANDTL	 R6006ANX
 R6007ENJ	 R6007ENX	 R6008ANJ	 R6008ANX	 R6008FNJ
 R600CH16FW0	 R600CH16FY0	 R600CH18	 R600CH18C2G0	 R600CH18D2G0
 R600CH18D2H0	 R600CH18FY0	 R600CH20	 R600CH20F2GO	 R600CH20FF0
 R600CH20FW0	 R600CH20FY0	 R600CH21	 R600CH21C2G0	 R600CH21C2H0
 R600CH25	 R600CH25F2HD	 R600DH25F2G2	 R6010830XXYA	 R6010830XXYA
 R6011ENX	 R6012630YA	 R6015ANZ	 R6020ANJTL	 R6020ANZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited